MAGX-001214-650L0x

GaN on SiC HEMT Pulsed Power Transistor
650 W Peak, 1200-1400 MHz, 300 µs Pulse, 10% Duty

Rev. V3

Features

- GaN on SiC Depletion-Mode Transistor Technology
- Internally Matched
- Common-Source Configuration
- Broadband Class AB Operation
- RoHS* Compliant and 260°C Reflow Compatible
- +50 V Typical Operation
- MTTF = 600 Years (T_J < 200 °C)

Applications

- L-Band pulsed radar.

Description

The MAGX-001214-650L0x is a gold-metalized matched Gallium Nitride (GaN) on Silicon Carbide (SiC) RF power transistor optimized for pulsed L-Band radar applications. Using state of the art wafer fabrication processes, these high performance transistors provide high gain, efficiency, bandwidth, and ruggedness over a wide bandwidth for today's demanding application needs. High breakdown voltages allow for reliable and stable operation under more extreme mismatch load conditions compared with older semiconductor technologies.

MAGX-001214-650L00

Ordering Information

Part Number	Description
MAGX-001214-650L00	GaN Transistor
MAGX-L21214-650L00	1200-1400 MHz Evaluation Board

Typical RF Performance Under Standard Operating Conditions, P_{OUT} = 650 W (Peak)

Freq. (MHz)	P_{IN} (W)	Gain (dB)	I_D (A)	Eff. (%)	RL (dB)	Droop (dB)	+1dB OD (W)	VSWR-S (3:1)
1200	8.7	18.8	21.3	61.0	-13.9	0.2	717	S
1250	8.5	18.9	22.0	58.9	-13.8	0.3	726	S
1300	8.0	19.1	22.4	57.8	-13.5	0.3	724	S
1350	7.0	19.7	21.8	59.7	-15.8	0.3	723	S
1400	7.0	19.7	21.1	61.4	-15.0	0.2	697	S

* Restrictions on Hazardous Substances, European Union Directive 2002/95/EC.

GaN on SiC HEMT Pulsed Power Transistor
650 W Peak, 1200-1400 MHz, 300 µs Pulse, 10% Duty

Rev. V3

Electrical Specifications: Freq. = 1200 - 1400 MHz, T_A = 25°C

Parameter	Test Conditions	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Units
RF Functional Tests						
Peak Input Power	V_{DD} = 50 V, I_{DQ} = 500 mA Pulse Width = 300 µs, Duty Cycle = 10% P_{OUT} = 650 W Peak (65 W avg.)	P_{IN}	-	7.5	10.3	W
Power Gain		G_P	18	19.5	-	dB
Drain Efficiency		η_D	55	60	-	%
Pulse Droop		Droop	-	0.3	0.6	dB
Load Mismatch Stability		VSWR-S	-	2:1	-	-
Load Mismatch Tolerance		VSWR-T	-	3:1	-	-

Electrical Characteristics: T_A = 25°C

Parameter	Test Conditions	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Units
DC Characteristics						
Drain-Source Leakage Current	V_{GS} = -8 V, V_{DS} = 175 V	I_{DS}	-	1.7	33	mA
Gate Threshold Voltage	V_{DS} = 5 V, I_D = 90 mA	$V_{GS\ (TH)}$	-5	-2.9	-2	V
Forward Transconductance	V_{DS} = 5 V, I_D = 21 mA	G_M	16.2	21.7	-	S
Dynamic Characteristics						
Input Capacitance	Not applicable - Input matched	C_{ISS}	N/A	N/A	N/A	pF
Output Capacitance	V_{DS} = 50 V, V_{GS} = -8 V, Freq. = 1 MHz	C_{OSS}	-	55	-	pF
Reverse Transfer Capacitance		C_{RSS}	-	5.5	-	pF

Absolute Maximum Ratings[1,2,3]

Parameter	Limit
Drain Voltage (V_{DD})	+65 V
Gate Voltage (V_{GG})	-8 to 0 V
Drain Current (I_{DD})	27 A
Input Power[4] (P_{IN})	P_{IN} (nominal) + 3 dB
Operating Junction Temperature[5]	250ºC
Peak Pulsed Power Dissipation at 85ºC	700 W
Operating Temperature Range	-40 to +85ºC
Storage Temperature Range	-65 to +150ºC
ESD Min. - Charged Device Model (CDM)	1300 V
ESD Min. - Human Body Model (HBM)	4000 V

1. Exceeding any one or combination of these limits may cause permanent damage to this device.
2. MACOM does not recommend sustained operation near these survivability limits.
3. For saturated performance it is recommended that the sum of (3 * V_{DD} + | V_{GG} |) < 175 V.
4. Input Power Limit is +3 dB over nominal drive required to achieve P_{OUT} = 650 W.
5. Operating junction temperature is measured with infrared (IR) microscope. Junction temperature directly affects a device's MTTF and should be kept as low as possible to maximize lifetime.
   - MTTF = 5.3 x 10^6 hours (T_J < 200°C)
   - MTTF = 6.8 x 10^4 hours (T_J < 250°C)

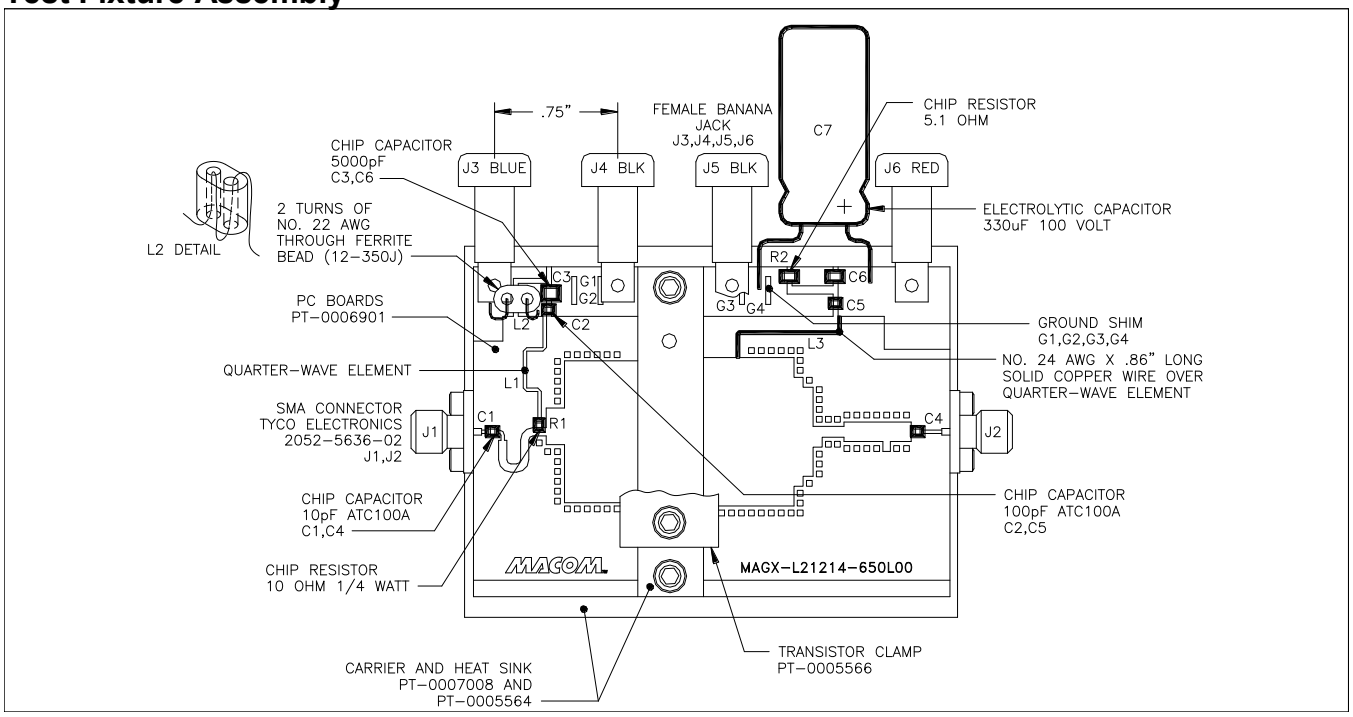
Thermal Characteristics

Parameter	Test Conditions	Symbol	Typical	Units
Thermal Resistance	T_C = 70ºC, V_{DD} = 50 V, I_{DQ} = 500 mA, P_{OUT} = 650 W Pulse Width = 300 µs, Duty Cycle = 10%	Θ_{JC}	0.25	°C/W

GaN on SiC HEMT Pulsed Power Transistor
650 W Peak, 1200-1400 MHz, 300 µs Pulse, 10% Duty

Rev. V3

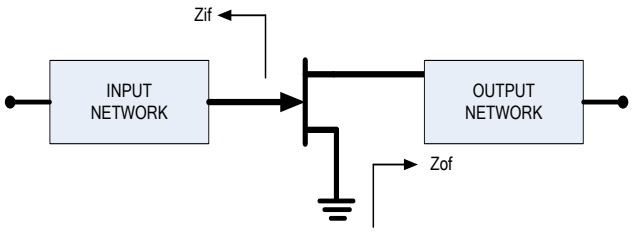
Test Fixture Assembly



Contact factory for gerber file or additional circuit information.

Test Fixture Impedances

F (MHz)	Z_{IF} (Ω)	Z_{OF} (Ω)
1200	0.8 - j0.9	1.4 + j0.2
1250	0.8 - j0.7	1.4 + j0.2
1300	0.7 - j0.6	1.4 + j0.1
1350	0.7 - j0.4	1.2 + j0.1
1400	0.7 - j0.2	1.1 + j0.2



Contact factory for gerber file or additional circuit information.

Correct Device Sequencing

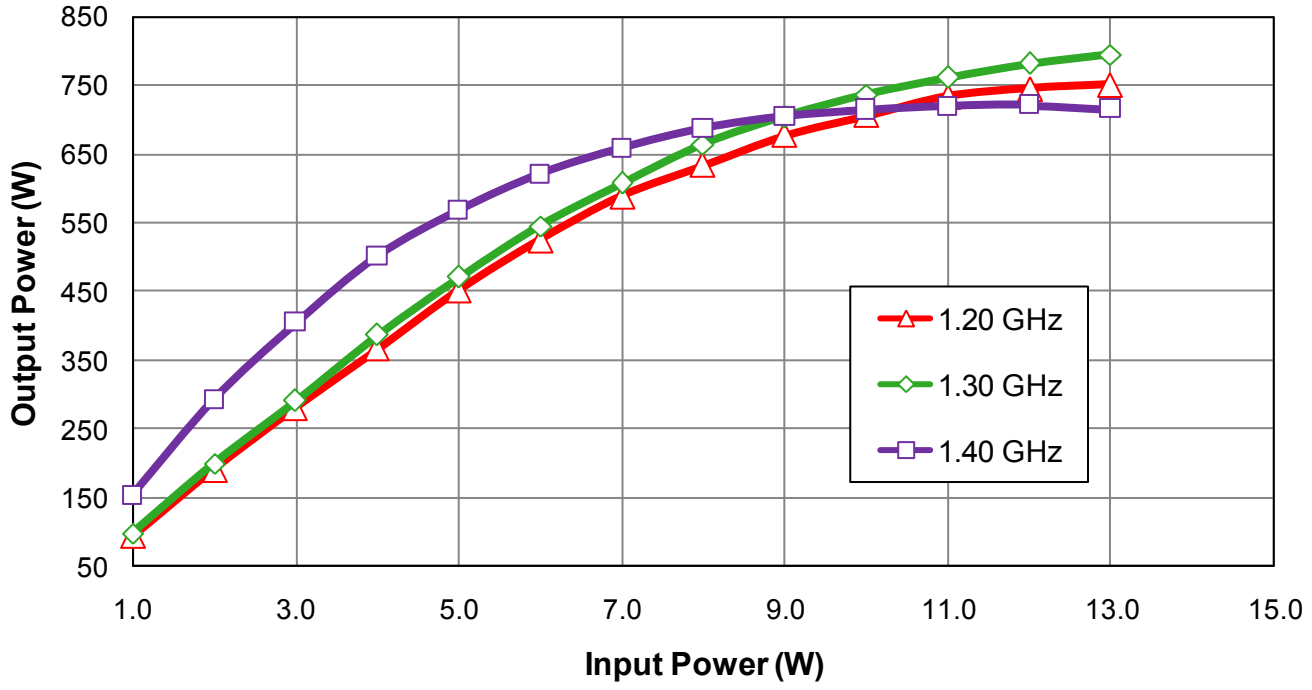
Turning the device ON

1. Set V_{GS} to the pinch-off (V_P), typically -5 V.
2. Turn on V_{DS} to nominal voltage (50 V).
3. Increase V_{GS} until the I_{DS} current is reached.
4. Apply RF power to desired level.

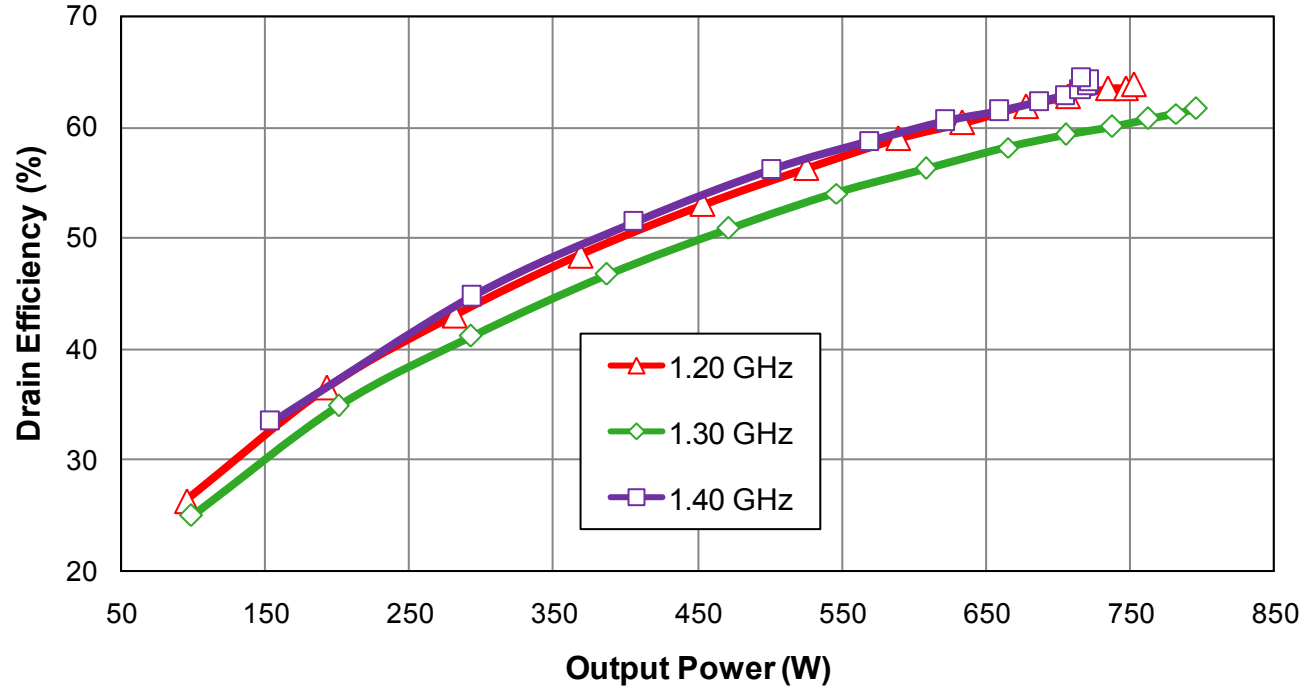
Turning the device OFF

1. Turn the RF power off.
2. Decrease V_{GS} down to V_P.
3. Decrease V_{DS} down to 0 V.
4. Turn off V_{GS}.

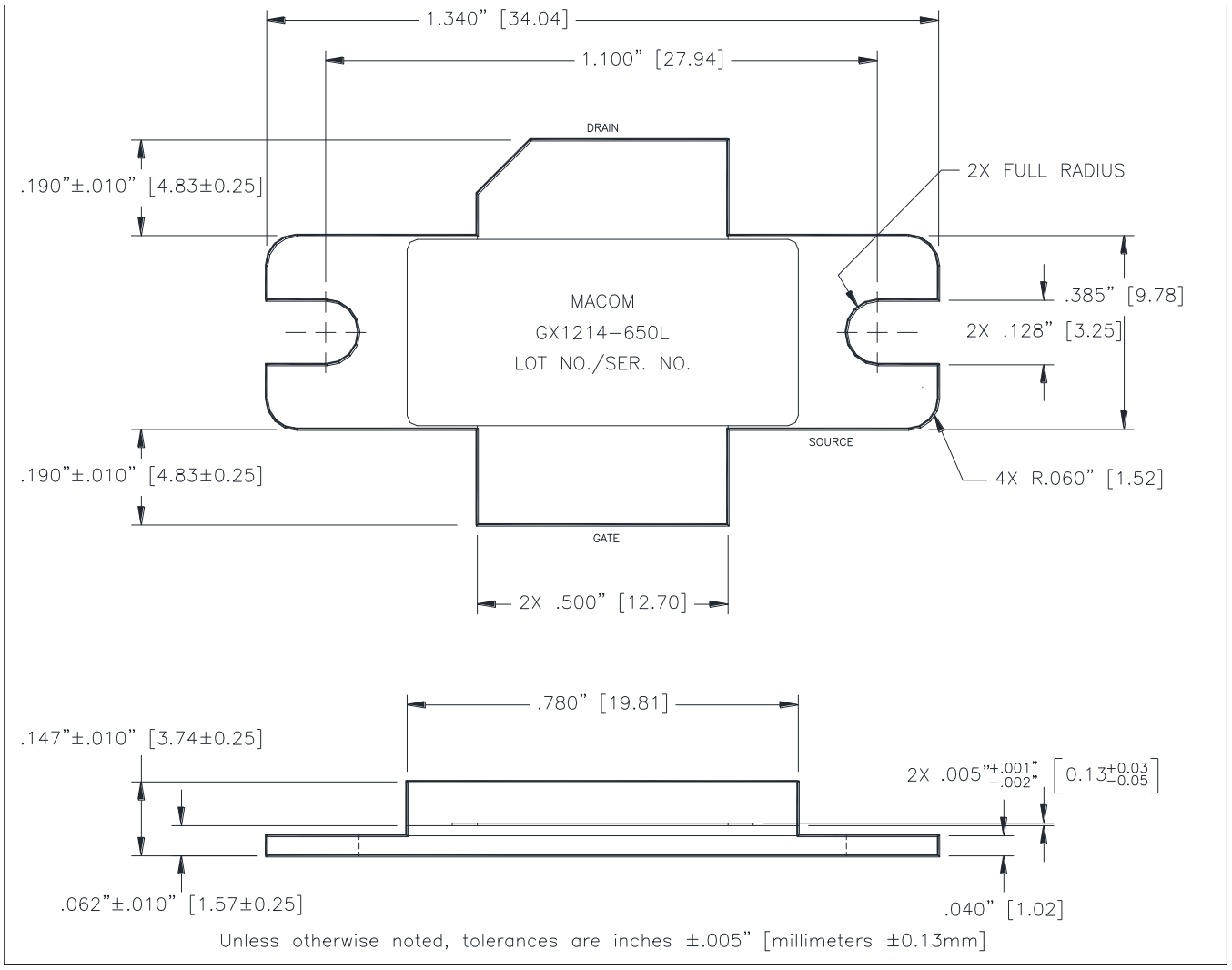
RF Power Transfer Curve (Output Power vs. Input Power)



RF Power Transfer Curve (Drain Efficiency vs. Output Power)



Outline Drawing MAGX-001214-650L00



OCEAN CHIPS
Океан Электроники
Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».

AVIC JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).

FORSTAR®

Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-03-32
Электронная почта: ocean@oceanchips.ru
Web: http://oceanchips.ru/
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А